LYORGODOTIPTO 20 MAR 2006

Japanese Patent Laid-Open Publication No. Sho 59-194393

Title of the Invention: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICES HAVING IMPROVED POWER CONVERSION EFFICIENCIES

Application No.: Sho 59-58088

Filed: March 26, 1984

Date of Publication of the Application: November 5, 1984

Priority claimed:

U.S. Patent Application No. 478938 filed on March 25, 1983

Applicant: Eastman Kodak Company (Rochester, NY)

What is claimed is:

1. An electroluminescent device comprising, in sequence, an anode electrode, a hole injection zone, an organic luminescent zone (said zones having a combined thickness that is no greater than 1 μ m), and a cathode electrode, wherein:

at least one of said electrodes is capable of transmitting at least 80% of incident radiation having a wavelength equal to or longer than 400 nm; and

said device has a power conversion efficiency of at least 9×10^{-5} W/W.

(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-194393

fint. Cl.3 H 05 B 33/14 // C 09 K 11/06 識別記号

庁内整理番号 7254-3K 7215-4H 砂公開 昭和59年(1984)11月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 12 頁)

砂改良された電力転換効率をもつ有機エレクト ロルミネツセント装置

②特

願 昭59-58088

@出

昭59(1984) 3 月26日

優先権主張

②1983年 3 月25日③米国(US)

@478938

@発明者

スチープン・アーランド・バン スリク

アメリカ合衆国ニューヨーク州 14613ロチエスター市ピアーポ ント・ストリート324

②発 明 者 チャン・ウオン・タン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14626ロチエスター市パーモン ト・ドライブ197

勿出 願 人 イーストマン・コダツク・カン パニー

アメリカ合衆国ニューヨーク州

14650ロチェスター市ステート

ストリート343

個代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外4名

蚏

1. [発明の名称]

改良された電力転換効率をもつ有機エレク トロルミネツセント袋筐

2. 「特許競求の顧用 〕

順次陽極、正孔インジエクション帝域、有機 発光帝城(これらの帝城を合わせた厚さは1mm を越えないし、および陰骸からなり、

これらの電極のうち少なくとも一方は400nm 以上の放長をもつ輻射線の少なくとも80%を 透過させることができ、かつ

少なくとも9×10 W/W の電力転換効率を もつエレクトロルミネツセント袋膛。

3. (発明の詳細な説明)

本発明は、有機化合物を発光手段とする。電 気信号に応答して発光するエレクトロルミネツ セントを敵に崩する。

有機エレクトロルミネツセント装置がそれら の対抗品と十分に対抗しつるものとなるために は、対抗しりるコストにおいてそれらの低力転

換効率が増大することが望ましい。電力伝換効 窓は入力に対する出力の比(通常はW/W)と 定義され、佞崖の枢動電圧の導致である。経済 的な枢動回路部品を用いる枢動域圧、十なわち 2.5 ポルトを継えない 雌圧に関しては、 難力転 換効率は無機長尾の場合1×10⁻¹W/W 以下に 限定されている。10W/W以上の電力転換効 率をもつ。厚いフィルム(> 5μπ) または単 結晶を用いる有機エレクトロルミネツセント袋 敵が開発されてはいる。しかしそれらの厚さが 比較的大きいため、との筺の毎歳を駆動させる のに要する単圧はかなり高い、すなわち100 ポルトまたはそれ以上である。

駆動盤圧を25ポルト以下に低下させるため 化は旗雕型エレクトロルミネッセント装置が望 ましい。これはことでは有効な奇域または暫の 厚さ、すなわち電板間にある物質の厚さが14m を蝕えない装蔵を意味する。ピンホールの問題 を考えると解膜の影響を遊成することは特に困 離であった。ピンホールは魔他をショートさせ

特問昭59-194393(2)

るので受入れられない。たとえばドレスナー、 RCAレビュー、Vol. 30、32211 頁 - (1969年6月)、特に326頁を参照され たい。ピンホールの形成を防止するために、被 獲用配合物中に結合剤を使用することが好都合 とされている。との種の結合剤の例には付加重 合体たとえばポリスチレン。および紹合重合体 たとえばポリエステルが含まれる。 観池のショ - トは難けられるが、結合剤を使用するととは 不満足を場合がある。このためには容剤被優加 工法を用いる必要があり、ある僧の啓剤は下僧 の密剤としても作用する可能性があり、これに より機関の明瞭な境界設定が妨げられる。結合 剤を必要とする1階を溶剤被獲したのち結合剤 を必要としない層(1増または多層)を蒸煮さ せる方法は考えられるが、逆の順序すなわち発 光幡を溶剤被覆する場合、溶剤が下槽に影響を 与えた場合の奥用性は証明されていない。

米国特許報4.356.429 号明細帯に記録された単池は、正孔インジェクション帯域

(hole injecting zone)としてポルフィリン系化合物からなる歯をもつ本発明のものと同じ型の袋橇の一例である。

上記符件のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、望まれている選力転換効率、
すなわち25ポルトを越えない戡動選圧を用いた場合に少なくとも9×10 W/W の水準を選びしていない。正れインジェクション層内のポルフィリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干吸収するという記ましくない傾同を示す。またポルフィリン系化合物は有効に発光するために必要な正化かよび電子の有効な発光的再始合を妨げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも 1 桁改良された、 すなわち少なくとも 9 × 1 0 W/W に及ぶ 電力 転換効率をもつエレクトロルミネッセント (以 下 " E L ") 製能を提供することである。

本発明によれば、順次陽極、正孔インジェク ション帯域、有機発光帯域(とれらの帯域を合

わせた厚さは1 um を越えない)、および陰極からなり、

これらの 芭蕉のうち少なくとも一方は400 nm 以上の皮長をもつ輻射額の少なくとも80%を 透過させることができ、かつ

少なくとも 9 × 1 0 W/W の 電力転換効率をも つエレクトロルミネンセント 装置が提供される。

びる)インジウム製陰極から構成される。

本発明の装置は必要とされる改良された難力 転換効率を示す。

本発明の後度において発光帝或または正孔インジェクション帝域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達化合物から作成され、これは本発明の実施感機の多くにおいてそれぞれの帝域に結合剤を用いずに行われる。

本発明の他の有利な特色は恐付の図面を考慮 に入れて疑記の好ましい実施想例を参照することにより明らかになるであろう。 第1 図は 電源 に接続した本発明装置の一部の無略的断面図であり、

4 2 図は本発明に従って製造された毎筐に似する 成力転換効率対エレクトロルミネジセント 量子効率を示す対数一対数グラフである。

特問昭59-194393(3)

正孔インジェクション 物質 かよび 発光物質は 各帯域内に存在する (この帯域が 階であっても 他のものでむっても)。 好ましいエレクトロル ミネッセント 接壁においてこれらの物質は質次 重なった装膜ないしは 個中に存在する。

正化インジェクション増は正孔伝達化合物からなり、一方発光膚は似子伝達化合物からなる。本発明者らは、凌配のように駆動かよび構成されるセルに用いた場合に 5×10 光子/健子を終える E L 献子効率を与える特定の選子伝達化合物があるととを見出した。 選力転換効率ととし、サウル合物を用いると前記の感動選圧に関して選力転換効率は少なくとも 9×10 W/Wとなることが保証される。これらの化合物は容易に複数の形態で改着するので、有効符域を合わせた複さが1 μm を越えない複数型医療が容易に複られる。

本発明の装置に用いられる電子伝導化合物は、 酸化環元反応において環元されりる化合物であ

動電圧をかけ、最大電子転換効率または25 ポルトのいずれかに選するまでしいずれが先に起 こるとしても)高める。この電圧において最大 EL最子効率を測定する。

接 | には、上記のように構成され、かつ上記の選圧で影動される接触において試験した場合の若干の有用な電子伝達化合物に関する尼し量子効率を示す。とれらの例のそれぞれにつき、 最大EL最子効率の選圧は25ボルトの制限以下であった。 る。本発明において有に有用なものは、前記の 試験に関して少なくとも 5×10⁴ EL酢子効塞 を与える電子伝達化合物である。 周知のように EL書子効塞は単純に外部回路で剛定される電子/秒に対する、セルから放出される光子/秒 の比に等しい。この効率を成力伝換効率(W/W の単位で定義される)と 温問してはならない。

銀子伝達化合物が少なくとも5×10⁶光子/ 電子(すなわち0.05%)の足し触子効果を与 えるか否かを判定するためには下記の試験を行 う。

Eしゃんは下記の顧序で構成される:
400 nm 以上の放長をもつ類対線の少なくとも80 を活過させる陽極[たとえばネザトロン(Nesatron. 商標) ガラス]: 本質的に1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル) シクロヘキサンからなる正孔インジェクション層: 問題の電子伝達化合物の層: およびインジウム製陰極。ここで正孔インジェクション階と発光層は合わせて厚さ1 aを越えない。駆

画院点における	1 8 V	2 0 V	2 0 V	15 V	125 V	2 4 V	1 5 V	14V	
	2×10	1×10³	8 × 1 0	3×10 ³	3×10	1.5×10°	5×10	8×10,	
**************************************	メゲトロン範囲/エピンドリジオン (1500Å)/インジウム(In 職働	(乃 気 色)。 ・ ナナトロン変換/H I - 1 (75nm)/E 1 (75nm)/I - 第第	・ *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *		・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ ************************************	・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

E5を除いて有効数子1個K四拾五入した。

特爾昭59-194393(4)

2 H I - 1 = 1.1 - ピス(4 - ジ- p - トリルアミノフェニル)シクロヘギサン

[4,4'-ヒス[5,7-ジt-ベンチル-2-ベンゾキサンリル]スチルペン]

4 E 2 = C, He C, He C (CHs), C

(2,5-ビス(5,7-ジーも・ペンチル・2-ペンゾキサゾリル]チオフェン]

5 E 5 = H H H C C = C - C = C - S

[22'-(14-フェレンジピニレン)ピスペンンデアゾール]

6 E4=

[2,2'-(4,4'-ピフェニレン)ピスペングチアゾール]

7 E5= ピス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウム

8 E 6 =

[2,5 - ビス[5 - (α,α - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン]

9 E7=

[2,5 - ビス[5,7 - ジー t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル] - 3,4 - ジフェニルチオフエン]

特閥昭59-194393(5)

ことで用いられる正孔インジェクション暦の正孔伝達化合物は、電場を与えられた2個の電極間に配成されて関係から正孔がインジェクトされた場合、正孔を適切に陰極へ伝達することができる化合物である。好ましい正孔伝達化合物は、10°~10°がルト/~200電場を与えられて電極間に解が配置された場合少なくとも10°ペパルト・砂の正孔移動係数をもつ。最も好ましい正孔伝達化合物は容易にかつ可逆的に飲化されりる芳香族アミンであることが見出された。

前記の光透過性をもつ有用な正孔伝達化合物 の好ましい例には、室風で固体であり、かつ少 なくとも1個の強素原子が魔換器でトリ魔換さ れた(そのうち少なくとも1個はアリール基または腹條アリール基である)アミンが含まれる。アリール基上の有用な腹換基の例には、1~5個の炭素原子をもつアルギル基、たとえばメチル基、ブロビル基、ブチル基 よびアミル基、ハロゲン原子、たとえば塩 ス原子 よびフン 業原子; ならびに1~5個の炭ス原子を有するアルコキン基、たとえばメトキン基、エトキン基、プロポキン基、ブテル基およびアミル基である。

本発明に用いられる正孔伝達化合物のあるもの、かよび電子伝達化合物のあるものは、 薄膜形成性化合物であるという付加的な性質をもつことが注目される。ここで用いられるようにある化合物がこの物質を電板などの支持体上に 0.5 μm 以下の厚さで施した場合に " 薄膜形成性 " である場合、これは異質的に ピンホールを含まない境を形成する。しかしある化合物が් 膜形成性であるということは必ずしも 0.5 μm よりも多様に存在しないということを意味する

わけではない。有効帯域の一方の簡がとの機の 修験形成性化合物である場合、両値において結 合剤を始くことができるという点でとの移腹形 成性は有用である。従って本発明の一実施駆破 においては、発光値および正孔インジェクショ ン帯域の反方が結合剤を含有しない。

あるいは他の場合には正孔と難子の発光的再 結合を妨げない結合剤も本発明に有用である。

たとえば被照形成性である正孔伝達化合物に は次式の調査をもつものが含まれる。

1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン:および次式の構造をもつ 化合物

(上記式中nは2~4の整数である). たとえば4.4-ビス(ジフェニルアミノ)クワドリフ

特問昭59-194393(6)

ェニ ル 。

さらに他の有用な正孔伝達化合物には米国等 許年4.175,960号明細盤13欄13行から 14欄42行に列挙されたもの。たとえばピス (4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) フェニルメタンかよびN、N、N-トリ(p-トリル)アミンが含まれる。

海峡形成性の電子伝達化合物に関しては、好ましい例には螢光増白剤が含まれる。最も好ましいものは次式の構造をもつ螢光増白剤である。

これらの式中R¹.R²、R³ およびR⁴ は別個に水 楽原子; 1~10個の炭栗原子を有する飽和脂肪族残益、たとえばプロビル基、も一プチル基 およびヘプチル基、6~10個の炭栗原子をするアリール基、たとえばフェニル基かよびナ ステル基・あるいはハログン原子、たとえばR³ とR⁴、またはR³とR⁴が一緒になって、1~10個の炭栗原子を有する飽和脂肪族残益(たとえばメテルム、エテル基かよびプロビル基(たくとも1個を含んでいてもよい紹の方法を完成するために必要な原子を解成し、

R*は1~20個の炭素原子を有する飽和脂肪族 残構、たとえばメチル基、エチル基却よびn-アイコンル基:6~10個の炭炭原子を有する アリール施、たとえばフェニル基かよびナフチ ル基:カルボギンル基:水業原子:シアノ基: あるいはハログン原子、たとえば塩素原子およ びフンス原子であり:ただし式c)において R*、R* およびRのうち少なくとも2個は3~ 10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残蓄、た とえばプロピル苺、プテル苺またはペプチル苺 であり、

Z ti - O - ... - NH - または - S - であり;Y $ti - R^{\bullet} + CH = CH + R^{\bullet} - ...$

mは0~4の整数であり:

n は 0 . 1 . 2 または 3 であり;

R は 6 ~ 1 0 個の 炭素原子を有する T リーレン店、 たとえばフェニレン基およびナフチレン 話であり:

R^{*} は水梨原子または6~10個の炭素原子を有するアリール基であり;そして Z^{*}およびZ^{*}は別個KNまたはCH である。 上記の脂肪族残毒は破換されていてもよい。健

特周昭59-194393(ア)

換された脂肪族機基の場合の健換基には、1~5個の炭素原子を有するアルキル基、たとえばメチル基、エチル基かよびブロビル基;6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェニル基かよびナフチル基;ハロゲン原子、たとえば塩器原子かよびフン素原子;ニトロ基;ならびに1~5個の炭素原子を有するアルコキン基、たとえばメトキン基。エトキン基かどでロボキン基が含まれる。

特に好ましい登光増白剤の例には下記のものが含まれる。2,5 - ビス(5,7 - ジー t - ペンチルー2 - ペンゾキサゾリル) - 1,3.4 - チアジアゾール;4,4'-ビス(5,7 - t - ペンチルー2 - ペンゾキサゾリル) スチルペン;2,5 - ビス(5,7 - ジーt - ペンチルー2 - ペンゾキサゾリル) チオフェン;2,2'-(p-フェニレンジピニレン) - ビスペンゾチアゾール;4,4'-ビス(2 - ペンゾキサゾリル) ピフェニル;2,5 - ビス(5 - (α.α - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン;4,4'-

ピス [5,7 - ジー (2 - メチルー 2 - ブチル)
- 2 - ベンゾキサゾリル] スチルベン: および
2,5 - ピス [5,7 - ジー (2 - メチルー 2 - ブ
チル) - 2 - ベンゾキサゾリル] - 3,4 - ジフェニルチオフェン。

さらに他の有用な優光増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637 買かよび640 買に列挙されている。ナでに複膜形成性ではないものは、一端または両端の関に脂肪族の基を結合させることによって複膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な優光増白剤には、たとえば下紀のものが含まれる。

[2-{2-[4-|2-ベンソイミダゾリル] フェニル] ビニル] ベンゾイミダゾール]

(5-メチル-2-(2-(4-(5-メチル-2-ベンゾキサゾリル)フェニル)ビニル)ベンゾキサゾール)

[2,5 - ヒス (5 - メチル - 2 - ベンゾキサゾ リル) チオフェン]

[2 - [2 - (4 - カルポキシフェニル) ビニル] ベンゾイミダゾ - ル] **シ**よび

[2-[2-(4-クロルフェニル]ビニル] ナフト[1,2-d]オギサゾール]

さらに他の有用な複膜形成性の電子伝達化合物には8-ヒドロキシキノリンの金属錯体が含まれ、その際金属は好ましくはZn. A8. Mg またはLi である。

有効層の一方が複模形成性である場合、容易に認められるようにピンホールのため設度がショートすることはないので、他方は薄膜形成性である必要はない。たとえば有用な装隆は、前記の海膜形成性化合物からなる正孔インジェクション暦、および薄膜形成性でない化合物、たとえば1,1,4,4 - テトラフェニル - 1,5 - ブタジェンからなる発光像を含む。

前紀の袋しから明らかなように、有用な陽極 塩幅には商牒"オザトロン"のもとにPPGイ

特開昭59-194393(8)

ンダストリーズ社から得られる被覆ガラス陽板 が含まれ、有用な関係遺極にはインジウムが含 まれる。一般のいかなる場構および路標もそれ が適切な仕事観改館をもつならば使用できる。 たとえば陽徳は高い仕事側数をもつべきである。 他の有用な機種の例にはいずれかの半透明な高 い仕事組織をもつ導電性材料。たとえば酸化ス ズインジウム、飲化スズ。ニンケルまたは金で 被扱したガラスが含まれる。好ましくは、との 種の陽低は10~1000ォーム/スクェアー (ohms/square)のシート抵抗、および400 nm 以上の彼長に対し80%の光透過率をもつ。 このように高い光透過器を少なくとも90まと いり正孔伝達化合物の透過率と合わせた場合に、 本発明に従って作成された装置の特色である卓 越したほ力転換効率が保証される。

他の有用な陰痿の例には低い仕事関数をもつ 他の金銭、たとえば銀、スズ、鉛、マグネシウム、マンガンおよびアルミニウムが含まれる。 金銭が毎世により発生するルミネッセンスに対 して高い透過率をもつか否かは関係ない。

第1回は本発明に従って製造されたエレクトロルミネッセント接触を示す。これは酸化スズインジウムの半透明被膜16で被優されたカラス製支持体14からなる陽極12を含む。これに正孔インジェクション僧18が配置される。 唐18かに正孔インジェクション僧18が配置される。 唐18かに近後である。 陰極22は変とのに接続する。 電26を入れると陽極12で発生した正孔に優18と20の界面へ伝達され、ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光線hレを発する。

電源 2 6 が接置 1 0 の最大出力点の電圧たと えば 1 5 ~ 2 5 ポルトで操作される場合。最大 電力転換効率は少なくとも 9 × 1 0 W/W であ る。ある場合にはこの効率が 2 × 1 0 に及ぶと とが認められた。本発明の接置は改良された電 力転換効率の結果 1700 cd/元(500フィー

トランベルト)に及ぶ最大輝度を生じることが 認められた。

本発明のEL接徹は常法により作成される。 すなわち正化インジェクション倍、発光層および 陰極をそれぞれ容被被覆法または蒸発により 施す。正孔インジェクション層が最初に形成されることが好ましい。 発光層に有用な溶剤で れることが好ましい。 発光層に有用な溶剤で れインジェクション層に対しても良好な溶剤で ある場合、発光層を形成するためには蒸発が好ましい。 ここで明いられる "蒸発"には蒸気相からのた潜のあらゆる形態が含まれ、真空下で 行われるものも含まれる。

下記の実施例により本発明をさらに説明する。 これらの実施例において最大環壁は不可逆的破 機を生じる成正のすぐ下の選正で側定される。 若干の実施例において駆動選圧について25V という好ましい吸収を越える輝度に関する選圧 が示されているのはこのためである。

奥施例 1

第1囪のものと類似したエレクトロルミネッ

セント袋鱧(以下"セル")を以下により製造した。

- 1) 陽額を作成するため、ネザトロンガラスをまず 0.05 Am アルミナの研摩材で数分間研摩した、次いでイソプロビルアルコールおよび蒸留水の1:1(の混合物中で超音波清浄した。次いでこれをイソプロビルアルコールですすぎ、選累で送風乾燥させた。最後に、使用前にこれをトルエン中で超音波清浄し、設累で送風乾燥させた。
- 2) 1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル) シクロへ中サン(HI-1)をネザトロンガラス上に一般的な真空蒸階法により沈滞させた。すなわち上配物質を選気的に加熱されたタンタル製ポートから320℃の爆躍で5×10°トルの系内圧力において蒸発させた。ネザトロンガラスに沈潛した生成HI-1フィルムの厚さは75nm であった。
- 3) 次いで4,4'-ピス(5,7 ジ- t ベンチル- 2 ペンゾキサゾリル)スチルベン(E1)

使用

を 2) に配成したと同じ手法を用いて、ただし供給液温度 3 5 0 ℃を採用して H I - 1 皆の上部に 沈滑させた。 E 1 倍の厚さも 7 5 nm であった。

4) 次いでインジウムをE1フィルムの上部に シャド-マスクを介して北滑させた。 In 戦極 の面践は Q.1 cdであり、これもエレクトロルミ ネッセントセルの有効面質を規定した。

出来上がったセルはネザトロンガラス電視をブラスとしてバイアスをかけた場合。 育緑色の 光を放出した。 放出された光は 5 2 0 nm 化最大放出を有していた。 違政された最大輝曜は与えられた電圧が 2 2 V である場合。 電流密曜 1 4 0 mA/cd 化かいて 3 4 0 cd/m であった。 2 0 V で駆動した場合、最大進力転換効率は 1.4×10³ W/W であり、 最大エレクトロルミネッセント 賢子効率は 1.2×10² 光子/電子であった。

奥施例2

檸р形成性でない正孔インジエクション層の

実施例1 化配収したよう化エレクトロルミネンセントセルを製造した。ただしN・N・N・トリ(p-トリル1 アミンを正孔インジェクション層としてHI-1の代わりに使用した。このアミンは次式の構造をもつ。

. 独開昭59-194393(9)

せんは実施例1に記載したものと同じ方法で製造された。ただしアミン蒸発のための供給源温度は120でであった。厚さは75 nm であった。このせんに30 Vをかけた場合、電研密で40mA/cd および最大輝度102 cd/㎡ が得られた。放出された光はこの場合も背縁色であり、520 nm に最大放出を有していた。

2 0 ボルトで驱動した場合、機大電力転換効率 は 8.1 × 1 0 W/W であり、最大EL電子効 窓は 6.9 × 10 光子/電子であった。

これらの結果は、発光層が薄膜形成性化合物 からなるためピンホールを含まないならば正孔 インジェクション催は薄膜形成性でなくてもよく、また結合剤を含有しなくてもよいことを証明している。

実施例3

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを 段後した。ただし下配の登光増白剤を発光階として明いた。

(2,5 - ビス (5,7 - ジ - t - ベンチル - 2 -ベンゾヰサゾリル) - 1,34 - チアジアゾ - ル) 実施例1と同様にして七ルを製造した。ただし蟹光増白剤の蒸発のための供給原温度は260℃であった。放出された光は橙色であり、590nmに极大放出を有していた。得られた最大輝度は30 V かよび40 mA/cdにかいて340cd/mであった。20 V で駆動された場合、最大電力伝換効率は1.5×10 W/W であり、最大EL電子効率は1.4×10 光子/な子であった。

発光増用の他の物質

実施例1と間様化してエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2.2-(p-フェニレンジピニレン)ピスペンソチアゾール(E3)を発光備として用い、300℃で蒸発させた。

E 3

とのセル(オザトロン/HI - 1/E3/In)

特局昭 59-194393 (10)

突施例5

発光費用の他の物質

前記契施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2-(4-ビフェニル)-6-フェニルペンゾキサゾール(PBBO)を発光層としてE1の代わりに用い、200℃で蒸発させた。

このセル(オザトロン/HI-1/PBBO/In)は白青色の光を放出した。 得られた最大輝度は 25 V シェび 50 mA/cd 化シいて 34 c d/㎡であった。 20 V で駆動した場合、最大電力転換効率は 9.5×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント最子効率は 8×10 光子/電子であった。

英施るおよび7

発光樹用の他の物質

突施例 1 と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし発光管はE1の代わりに 2,5 - ピス [5 - (α,α-ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル] チオフエン (実施例 6) および 2,5 - ピス [5,7 - ジー t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル] - 3,4 ~ ・ジフェニルチオフェンからなり、340℃の温 医で蒸発させた。 喪 [に 告 果を示す。

- X	める観響を開発をある。	1 S V	14V
	編 名 兄 子 谷 兄 兄 敬	5×10° 44/模斗	1.4×10 84×10 W/W 数子/電子
	最富僚大力物を変	7×10 W/W	1.4 × 10 W / W
	後轉大應	680cd/m² (19V5LG 150mA/d² 'K±vrT!	1700ed/m' (20V&LG 300mA/cd K&MT)
	表故	530 am	•
	4B)	₩.	·
	東路河	•	^

突施例8

薄膜形成性でない 電子伝達化合物

実施 例 1 と同様化 してエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし、 1, 1, 4, 4 - テトラフェニル - 1, 3 - ブタジエン (TPB) を発光層として用いた。

TPB昇駆のための供給領温度は210℃であった。 このせんは背色の光を放出し、 これは450 nm に最大放出を有していた。 得られた輝度は20Vかよび200mA/cm において102cd/m であった。15 Vで駆動した場合、最大 電力 転換効率は2×10 W/W であり、 最大エレクトロルミネッセント 量子効率は1.2×10 光子/ 電子であった。このセルは蒸発したTPB

特開昭59-194393(11)

の構造をもつピス(8-ヒドロギシギノリノ)

マグネシウムをそれぞれ発光質として用いた。

操作条件は実施例 1 の配収と同様であった。た だし金属館体の供給源温度はそれぞれる30℃

(実施例9) かよび410 °C (実施例10) で

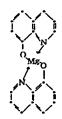
あった。袋∥に結果を示す。

簡の不均関なかつ薄膜形の性でない性質にもかかわらず機能した。TPB層は顕微鏡下で見た場合小さなクラスターのモザイクの外膜を有していた。

奥施例タかよび10

電子伝達化合物として B - ヒドロキシギノリノ の金減罐体を使用

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただしピス(d - ヒドロキシキノリノ) アルミニウム(実施例9)、 および次式



(実施例10

上配各実施的に示した効率を便宜のため第2 図にプロットした。第2図の点線は傾向を示す にてぎず、いずれかの方法による最適なものを 表わすものではない。そこに示されたデータは 傾係式

● log(電力転換効率) = Log(EL 城子効率) + Log K (上記式中 K は 切片 (intercept) であり、 駆動 電圧によって一部制御される係效である) に従うとほぼ直線状である。 駆動 電圧(事 1 図 の 電源 2 6) の値が上がるのに伴って、 事 2 図 の 曲線は下方へ移動する。 佐ってより 高い 駆動 電圧では、 同一の EL 量子 効率でも、 もはや 希 望する 9 × 1 0 W/W の 配力 転換効率を与えないようになるであろう。

4. [図面の簡単な説明]

第1図は気源に接続した本発明を産の一部の 気略的新面図であり、

第2回仕本発明接近に関する電力転換効率対 エレクトロルミネッセント最子効率を示す対数 - 対数グラフである。

	路電力		24V
	最 日 子 	5.8×10 光子/位子	1.5×10 光子/粒子
	极大 原物的形 (W/W)	82×10+	1.4×10+
嵌	表 類 (F / P / L)	340 (15V**LC) 50mA/cd	1247年) 340 (247かほび 100mA/ゴ において)
	数田数田なれられる。	夢 515nm	548 _{nm.}
	政策の発送のの数据を表している。	蹙	欜
	张 图	٥	0

特問昭59-194393 (12)

図中の各記号は下記のものを嵌わす。

10:エレクトロルミネツセント装置;

12:陽橋; 14:ガラス製支持体;

16:半透明被瞭;

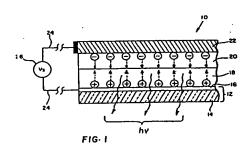
18:正孔インジェクション幅; 20:発光層;

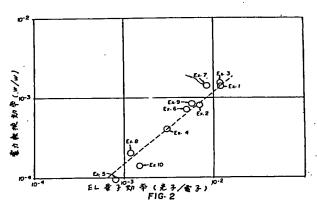
22:路極: 24:リードワイヤ;

26: 遺源。

ち許出頭人 イーストマン・コダック・カンパニー

代理人弁理士 湯 後 恭 三 湯





-456-